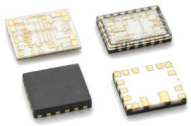
Каталог продукции

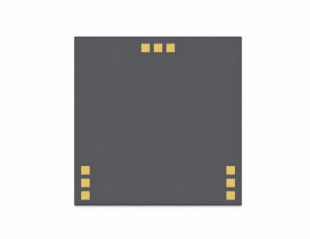
Интегрированные пассивные ВЧ-устройства

Интегрированные пассивные устройства объединяют элементы на одной подложке или в корпусе. В ВЧ-трактах они выполняют согласование, фильтрацию, симметрирование или связь.



Продукция: 32

Редакция: 11 · Дата редакции: 2026-11-11



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 2 × 2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 18000; Значение: 2000–18000; Единица: MHz

Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 3700; Максимум: 5000; Значение: 3700–5000; Единица: MHz

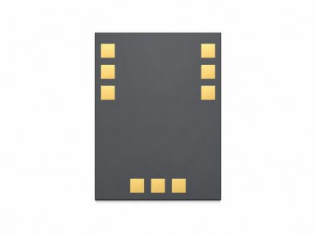
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 14 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 500; Максимум: 2700; Значение: 500–2700; Единица: MHz

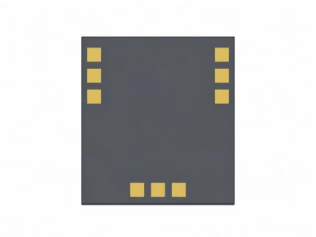
Развязка: Типовое: 14; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 18 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 800; Максимум: 2000; Значение: 800–2000; Единица: MHz

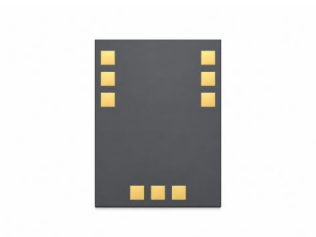
Развязка: Типовое: 18; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 18 dB (типовое); Входной КСВН: 1.4 (типовое); Выходной КСВН: 1.4 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 1000; Максимум: 4000; Значение: 1000–4000; Единица: MHz

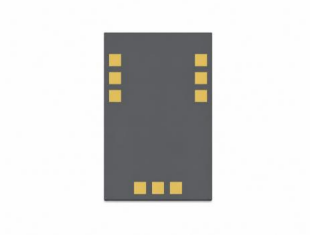
Развязка: Типовое: 18; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4

Выходной КСВН: Типовое: 1.4

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

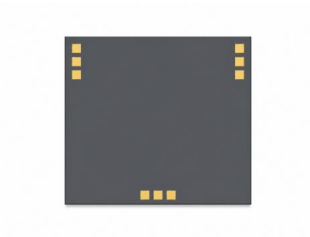
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 18000; Значение: 2000–18000; Единица: MHz

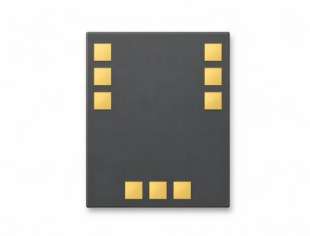
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 30 dB (типовое); Входной КСВН: 1.1 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2700; Максимум: 3500; Значение: 2700–3500; Единица: MHz

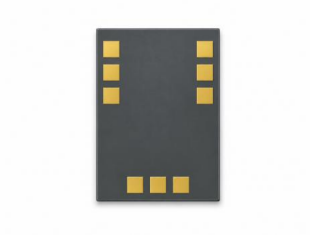
Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.1

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.1 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 7000; Значение: 5000–7000; Единица: MHz

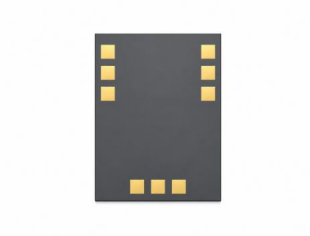
Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.1

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 13000; Значение: 5000–13000; Единица: MHz

Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

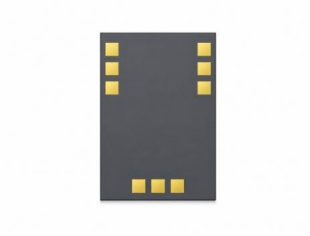
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 7000; Максимум: 13000; Значение: 7000–13000; Единица: MHz

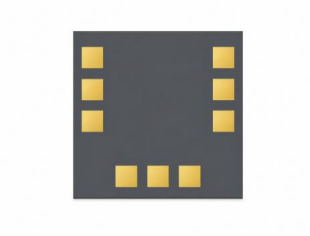
Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

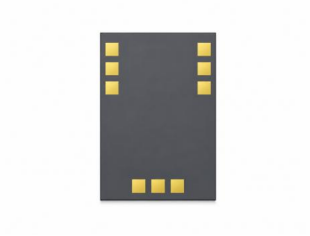
Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 30 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.2 (типовое). Размеры кристалла: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 10000; Максимум: 20000; Значение: 10000–20000; Единица: MHz

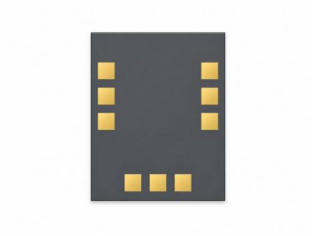
Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 25 dB (типовое); Входной КСВН: 1.2 (типовое); Выходной КСВН: 1.1 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 12000; Максимум: 18000; Значение: 12000–18000; Единица: MHz

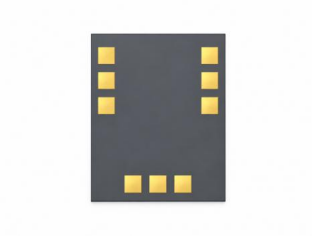
Развязка: Типовое: 25; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2

Выходной КСВН: Типовое: 1.1

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz Кристалл 2-канального делителя мощности GaAs IPD, 0°

Развязка: 20 dB (типовое); Входной КСВН: 1.3 (типовое); Выходной КСВН: 1.3 (типовое). Размеры кристалла: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 30000; Максимум: 40000; Значение: 30000–40000; Единица: MHz

Развязка: Типовое: 20; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.2 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.2

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 4 dB

Ослабление: 4 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 4; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 16 dB

Ослабление: 16 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 16; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.6 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.6; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.4 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.4

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 5 dB

Ослабление: 5 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 5; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 6 dB

Ослабление: 6 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 6; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 10 dB

Ослабление: 10 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

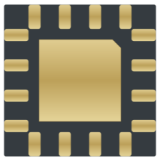
Ослабление: Значение: 10; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz Перекрёстный RF-переход в корпусе — ISO 30 dB (типовое)

DC–40000 MHz; Вносимые потери -1.4 dB (типовое); Развязка 30 dB (типовое).

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: DC; Максимум: 40000; Значение: DC–40000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: -1.4; Единица: dB

Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Типовое: 1.2

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.